

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука" (Санкт-Петербург)

Том: 51 Номер: 3 Год: 2017

- МОНОКРИСТАЛЛЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (FEIN2S4)X (CUIN5S8)1-X : КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, СПЕКТРЫ ЯДЕРНОГО ГАММА-РЕЗОНАНСА И ТЕПЛОЕ РАСШИРЕНИЕ** 291-296
Боднарь И.В., Жафар М.А., Касюк Ю.В., Федотова Ю.А.
- КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ В ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ТЕРМОМИГРАЦИИ** 297-301
Лозовский В.Н., Ломов А.А., Лунин Л.С., Середин Б.М., Чесноков Ю.М.
- ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ЧИСТОМ, СЛАБОКОМПЕНСИРОВАННОМ ГЕРМАНИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПОЛЯ ПРОБОЯ** 302-304
Банная В.Ф.
- АТОМНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОРОДА НА ДИСЛОКАЦИЯХ В КРЕМНИИ** 305-310
Высотский Н.В., Лошаченко А.С., Вывенко О.Ф.
- ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ БОМБАРДИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ НА ПРОВОДИМОСТЬ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ N-4H-SiC (CVD)** 311-316
Козловский В.В., Лебедев А.А., Стрельчук А.М., Давыдовская К.С., Васильев А.Э., Макаренко Л.Ф.
- ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ N+ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ ПОЛУИЗОЛИРУЮЩЕГО АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ В ИК-ОБЛАСТИ СПЕКТРА** 317-321
Клюй Н.И., Лозинский В.Б., Липтуга А.И., Дикуша В.Н., Оксанич А.П., Когдась М.Г., Перехрест А.Л., Притчин С.Э.
- ГЕНЕРАЦИЯ ТЕРАГЕРЦЕВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЛЕНКАХ INGAAS НА ПОДЛОЖКАХ INP С ОРИЕНТАЦИЕЙ (100) И (411) А** 322-330
Галиев Г.Б., Грехов М.М., Китаева Г.Х., Климов Е.А., Клочков А.Н., Коленцова О.С., Корниенко В.В., Кузнецов К.А., Мальцев П.П., Пушкарев С.С.
- ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЛЕГИРОВАНИЯ CU НА СПЕКТРЫ ОТРАЖЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ PBSB2TE4** 331-334
Немов С.А., Улашкевич Ю.В.
- ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ D D-ПЕРЕХОДЫ НА ЦЕНТРАХ ВОЛЬФРАМА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ AПВVI** 335-338
Ушаков В.В., Кривобок В.С., Пручкина А.А.
- РАЗМЕРНЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК СЕЛЕНИДА КАДМИЯ ВО ФТОРОФОСФАТНЫХ СТЕКЛАХ** 339-341
Липатова Ж.О., Колобкова Е.В., Бабкина А.Н., Никоноров Н.В.
- РАЗРЫВЫ ВАЛЕНТНОЙ ЗОНЫ В НАПРЯЖЕННЫХ СЛОЯХ SIGESN/SI С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОЛОВА** 342-347
Блошкин А.А., Якимов А.И., Тимофеев В.А., Туктамышев А.Р., Никифоров А.И., Мурашов В.В.
- ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АНИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ NiO/CDTE** 348-357
Пархоменко Г.П., Солован М.Н., Мостовой А.И., Ульяницкий К.С., Марьянчук П.Д.
- ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АНИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ NiO/CDTE** 358-362
Пархоменко Г.П., Солован М.Н., Мостовой А.И., Ульяницкий К.С., Марьянчук П.Д.
- ФОРМИРОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ A-SiOX /ДИЭЛЕКТРИК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СИНХРОТРОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ** 363-366
Турищев С.Ю., Терехов В.А., Коюда Д.А., Ершов А.В., Машин А.И., Паринаова Е.В., Нестеров Д.Н., Грачев Д.А., Карабанова И.А., Домашевская Э.П.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ И СОЕДИНЕНИЙ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК	367-371
<i>Кирсанов Н.Ю., Латухина Н.В., Лизункова Д.А., Рогожина Г.А., Степихова М.В.</i>	
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ НАНОСТРУКТУР "КВАНТОВАЯ ЯМА-ТОЧКИ", ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ	372-377
<i>Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Надточий А.М., Максимов М.В., Рувимов С.С., Жуков А.Е.</i>	
ФАЗОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА В СТРУКТУРАХ С ДВОЙНЫМИ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ В ПРОДОЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ	378-382
<i>Балагула Р.М., Винниченко М.Я., Махов И.С., Софронов А.Н., Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е.</i>	
ОСОБЕННОСТИ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МДП-СТРУКТУРЫ $\text{Cu-SiO}_2\text{-P-INSB}$	383-385
<i>Алиев Р.А., Гаджиев Г.М., Гаджиалиев М.М., Исмаилов А.М., Пирмагомедов З.Ш.</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБОКИХ ЦЕНТРОВ В МИКРОПЛАЗМЕННЫХ КАНАЛАХ ФОСФИДГАЛЛИЕВЫХ СВЕТОДИОДОВ ЗЕЛЕННОГО СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ	386-389
<i>Ионычев В.К., Шестеркина А.А.</i>	
ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ $4\text{H-SiCP}+\text{N}_0\text{-N}+$ ДИОДОВ В РЕЖИМЕ ЛАВИННОГО ПРОБОЯ	390-394
<i>Иванов П.А., Потапов А.С., Самсонова Т.П., Грехов И.В.</i>	
ALN/GAN-ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ДЛЯ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫХ ТРАНЗИСТОРОВ	395-402
<i>Журавлев К.С., Малин Т.В., Мансуров В.Г., Терещенко О.Е., Абгарян К.К., Ревизников Д.Л., Земляков В.Е., Егоркин В.И., Парнес Я.М., Тихомиров В.Г., Просвиринов И.П.</i>	
ИМПУЛЬСНОЕ ЛАЗЕРНОЕ НАПЫЛЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ И GaP НА ПОДЛОЖКАХ Si ДЛЯ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	403-408
<i>Лунин Л.С., Лунина М.Л., Девицкий О.В., Сысоев И.А.</i>	
СВОЙСТВА ПЛЕНОК $\text{ZnO} : \text{Er}^{3+}$, ПОЛУЧЕННЫХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ	409-413
<i>Малютина-Бронская В.В., Семченко А.В., Сидский В.В., Федоров В.Е.</i>	
ОТДЕЛЕНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР III N/SiC ОТ ПОДЛОЖКИ Si И ИХ ПЕРЕНОС НА ПОДЛОЖКИ ДРУГИХ ТИПОВ	414-420
<i>Кукушкин С.А., Осипов А.В., Редьков А.В.</i>	
СТРУКТУРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОНИТЕЙ КАРБИДА КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАРБИДИЗАЦИЕЙ КРЕМНИЕВЫХ НАНОСТРУКТУР	421-425
<i>Павликов А.В., Латухина Н.В., Чепурнов В.И., Тимошенко В.Ю.</i>	
ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ НА МИШЕНИ НА СВОЙСТВА ПЛЕНОК $\text{SnO}_2 : \text{Sb}$ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКОРОСТНОГО СЕПАРАТОРА ЧАСТИЦ	426-430
<i>Паршина Л.С., Храмова О.Д., Новодворский О.А., Лотин А.А., Петухов И.А., Путилин Ф.Н., Щербачев К.Д.</i>	